(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-230596

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

| (51) Int.CL.6 | | 識別記号 | 庁内整理番号 | ΡI | | 技術 | 術表示箇所 | | | | |
|---------------|--------|-------------------|--------|---------|----------|--------------|---------|-------|--|--|--|
| G03F | 7/039 | 501 | | G03F | 7/039 | 501 | | | | | |
| | 7/004 | 503 | · | | 7/004 | 503 | | | | | |
| | 7/022 | | | | 7/022 | | | | | | |
| | 7/033 | | | | 7/033 | | | | | | |
| H01L | 21/027 | | | HO1L 2 | 21/30 | 5021 | R | | | | |
| | | | | 審查請求 | 未請求 | 請求項の数1 | OL (全 | 13 頁) | | | |
| (21)出願番号 | | 特顯平8-36458 | | (71)出題人 | 0000041 | 78 | | | | | |
| | | | | | | 日本合成ゴム株式会社 | | | | | |
| (22)出顧日 | | 平成8年(1996) 2 | | 東京都 | 中央区築地2丁目 |]]]福24号 | | | | | |
| | | | | (72)発明者 | 下川 | 旁 | | | | | |
| | | | | | 東京都中 | 中央区築地二丁目 | 111番24号 | 日本合 | | | |
| | | | · . | | 成ゴム村 | 特式会社内 | | | | | |
| | | | | (72)発明者 | 杉油 | 读 | | | | | |
| | | | | | 東京都中 | 中央区築地二丁目 | 311番24号 | 日本合 | | | |
| | | | | | 成ゴム | 朱式会社内 | | | | | |
| | | | | (72)発明者 | 宇高 2 | 友広 | | | | | |
| | | | | | 東京都中 | 中央区築地二丁目 | 111番24号 | 日本合 | | | |
| | - | | | | 成ゴム | 朱式会社内 | | | | | |
| | | | | (74)代理人 | 弁理士 | 大島 正孝 | | | | | |
| | | | | | | | 最終 | 質に続く | | | |

(54) 【発明の名称】 國放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 IC、LCD用TFT回路などの回路製造用であって、耐薬品性、感度、現像性、残膜率、耐熱性および基板との密着性に優れた、アルカリ水溶液からなる現像液によって現像しうるポジ型レジストとして好適な感放射線性樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】 [A] (a-1) 不飽和カルボン酸の重合単位および (a-2) 下記一般式 [I]

【化1】(式中、R1~R3は各々独立に、水素原子または炭素数1~5のアルキル基であり、R4は炭素数1~5のアルキル基であり、mおよびnは互に独立に1~5の整数である。)で表される化合物の重合単位を含有する共重合体、

- [B] 1,2-キノンジアジド化合物、並びに
- [C]潜在性酸発生剤、を含有する感放射線性樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 [A] (a-1)不飽和カルボン酸の重合単位および (a-2)下記一般式 [I]

$$\begin{array}{c} R_1 & R_3 \\ R_2 & \\ R_2 & \\ [(CH_2O)_nR_4]_n \end{array} \cdots [I$$

(式中、R1~R3は各々独立に、水素原子または炭素数 1~5のアルキル基であり、R4は炭素数1~5のアル キル基であり、mおよびnは互に独立に1~5の整数で ある。)で表される化合物の重合単位を含む共重合体、 [B] 1,2−キノンジアジド化合物、並びに

[C]潜在性酸発生剤、を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、半導体集積回路(以下、「IC」という)、液晶ディスプレイ(以下、「L 20 CD」という)用薄膜トランジスタ(以下、「TFT」という)回路などの回路製造用のポジ型レジストとして、あるいは層間絶縁膜、カラーフィルタ用保護膜などの永久膜形成材料としても好適な、感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路の製造において は、高解像度を有するとともに高感度を有するレジスト として用いられる感放射線性樹脂組成物が求められてい る。

【0003】即ち、I Cの製造の際には、サブミクロン以下の高解像度が得られるレジストが要求されることもあるが、他方では数μm~数十μmオーダーの解像度が得られ、且つ特に大口径化されたシリコンウェハを用いてスループットを上げても高い歩留まりを示す高感度レジストが強く要望されている。

【0004】また、例えばICの製造の際のシリコンウェハのエッチング工程では、大量にバッチ処理が可能なウェットエッチング方式で行われることが多く、このため形成されるレジストパターンには、基板との密着性や 40エッチング液に侵されない耐薬品性が必要とされる。またイオンインプラ工程などが加わる場合には、高温加熱に耐えうる耐熱性が要求される。

【0005】従来、I Cの製造の際に用いられるレジストとしては、ノボラック樹脂と1,2-キノンジアジド化合物とを含むボジ型レジストが知られている。しかしながら、このボジ型レジストは、解像度には優れているが、上記のようなウェットエッチングに耐えうる耐薬品性、さらには感度、基板との密着性、耐熱性などについては充分な特性を有しているとはいえない。

2

【0006】また近年、急速に発展してきたしてDにおいて、LCDの中でもとりわけ1画素ごとにTFTを組み込んだアクティブマトリクス型LCD(以下、「AMーLCD」という)は、その応答速度の早さからブラウン管に代わる次世代表示デバイスの本命とみなされており、表示画面の大面積化が望まれている。このようなAMーLCDのTFT回路の形成にも、ICの場合と同様にレジストが用いられている。

【0007】さらにLCDを製造する際には、従来熱硬化性樹脂組成物を用いて形成されている層間絶縁膜、カラーフィルター用保護膜などの永久膜を、レジストと同様の組成物で形成しようとする試みが行われている。

【0008】このようなLCDの永久膜には、耐薬品性、基板との密着性、耐熱性、可視光領域における透明性などが要求されるが、上記のようなノボラック樹脂とキノンジアジド化合物とを含む従来のボジ型レジストでは、耐薬品性、基板との密着性、耐熱性などの点で充分満足のいく永久膜を形成できるものではなかった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、新しい感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明の他の目的は、IC、LCD用TFT回路などの回路製造用であって、耐薬品性、感度、現像性、残膜率、耐熱性および基板との密着性に優れた、アルカリ水溶液からなる現像液によって現像しうるポジ型レジストとして好適な感放射線性樹脂組成物を提供することである。

【0010】本発明のさらに他の目的は、LCDの層間 絶縁膜、カラーフィルター保護膜、回路保護膜などで例 示される永久膜を形成するためのものであって、耐熱 30 性、基板との密着性、可視光領域における透明性、耐薬 品性などに優れた永久膜を与え得る感放射線性樹脂組成

[0011]

物を提供することである。

【発明を解決するための手段】本発明の上記目的および 利点は、

[A] (a-1) 不飽和カルボン酸の重合単位および (a-2) 下記一般式 [I]

[0012]

【化2】

$$\begin{array}{c} R_1 & R_3 \\ R_2 & \end{array}$$
 (CH₂O)₋R₄]_n

【0013】(式中、R1~R3は各々独立に、水素原子または炭素数1~5のアルキル基であり、R4は炭素数1~5のアルキル基であり、mおよびnは互に独立に1~5の整数である。)で表される化合物の重合単位を含有する共重合体(以下、「共重合体[A]」ともいう)、[B] 1,2-キノンジアジド化合物、並びに

50 [C] 潜在性酸発生剤、を含有することを特徴とする感

放射線性樹脂組成物によって達成される。以下、本発明 を詳述するが、それにより本発明の他の目的、利点およ び効果も明らかとなろう。

【0014】以下、まず本発明に係る感放射線性樹脂組 成物に含まれる各成分について説明する。なお、本発明 で「放射線」という語は、紫外線、遠紫外線、X線、電 子線、分子線、ア線、シンクロトロン放射線、プロトン ビーム線などを含む概念で用いられる。

【0015】共重合体 [A]

本発明で用いられる共重合体 [A]は、不飽和カルボン 10 酸(a-1)の重合単位および上記一般式[I]で示さ れる化合物 (a-2) の重合単位を共重合成分として含 有し、必要に応じて上記不飽和カルボン酸(a-1)お よび化合物(a-2)と共重合しうる他のラジカル重合 性化合物(以下、「他のラジカル重合性化合物」ともい う。) (a-3) の重合単位を共重合成分としてさらに 含有することができる。

【0016】本発明で用いられる上記不飽和カルボン酸 (a-1)としては、エチレン性不飽和二重結合を有す る不飽和カルボン酸を好ましいものとして挙げられる。 【0017】 このような不飽和カルボン酸(a-1)の 具体例としては、メタクリル酸、アクリル酸、クロトン 酸、oービニル安息香酸、mービニル安息香酸、pービ ニル安息香酸などのモノカルボン酸;マレイン酸、フマ ル酸、シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸、1,4 ーシクロヘキセンジカルボン酸、3ーピニルフタル酸、 4-ビニルフタル酸、メチルー5-ノルボルネンー2. 3-ジカルボン酸、3,4,5,6-テトラヒドロフタル 酸、1,2,3,6ーテトラヒドロフタル酸、ジメチルテ トラヒドロフタル酸などのジカルボン酸が挙げられる。 これらのうち、メタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸 などが好ましく用いられる。

【0018】また、本発明では、不飽和カルボン酸(a -1)として、カルボン酸基の一部が遊離のまま残存し ている、上記不飽和カルボン酸の部分エステル化物また は部分アミド化物、例えば不飽和ジカルボン酸のハーフ エステルまたはハーフアミドを用いることもできる。こ のような不飽和カルボン酸のハーフエステルまたはハー フアミドとしては、イタコン酸モノメチル、イタコン酸 モノブチルなどが好ましく用いられる。これらの不飽和 40 カルボン酸は、単独であるいは2種以上組み合わせて用 いることができる。

【0019】本発明で使用される化合物(a-2)は、 上記一般式 [I] で表される。式 [I] 中において、R 1~R3は各々独立に水素原子または炭素数1~5のアル キル基であり、Rょは炭素数1~5のアルキル基であ り、mおよびnは互に独立に1~5の整数である。上記 炭素数1~5のアルキル基は、直鎖状であっても分岐鎖 状であってもよく、例えばメチル基、エチル基、プロピ

cーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基などを 挙げることができる。

4

【0020】上記一般式 [I]で示される化合物(a-2) の具体例としては、例えば、oーピニルベンジルメ チルエーテル、mービニルベンジルメチルエーテル、p ービニルベンジルメチルエーテル、oービニルベンジル エチルエーテル、mービニルベンジルエチルエーテル、 pービニルベンジルエチルエーテル、oービニルベンジ ルプロピルエーテル、mービニルベンジルプロピルエー テル、pービニルベンジルプロピルエーテル、oービニ ルベンジルイソプロピルエーテル、mービニルベンジル イソプロピルエーテル、pービニルベンジルイソプロピ ルエーテル、oービニルベンジルプチルエーテル、m-ビニルベンジルブチルエーテル、p-ビニルベンジルブ チルエーテル、oーピニルベンジルイソブチルエーテ ル、mービニルベンジルイソプチルエーテル、pービニ ルベンジルイソブチルエーテル、oービニルベンジルー tertーブチルエーテル、mービニルベンジルーte rtープチルエーテル、pービニルベンジルーtert ブチルエーテル、αーメチルーοービニルベンジルメチ ルエーテル、αーメチルーmービニルベンジルメチルエ ーテル、α-メチル-p-ビニルベンジルメチルエーテ ル、2,3-ジメトキシメチルスチレン、2,4-ジメト キシメチルスチレン、2,5-ジメトキシメチルスチレ ン、2,6-ジメトキシメチルスチレン、2,3,4-トリメトキシメチルスチレン、2,3,5-トリメトキシメ チルスチレン、2,3,6-トリメトキシメチルスチレ ン、3,4,5-トリメトキシメチルスチレン、2,4,6 ートリメトキシメチルスチレンなどを挙げることができ 30 る。

【0021】これらのうち、oービニルベンジルメチル エーテル、mービニルベンジルメチルエーテル、pービ ニルベンジルメチルエーテル、oービニルベンジルエチ ルエーテル、mービニルベンジルエチルエーテル、pー ビニルベンジルエチルエーテルなどが好ましく用いられ る。これらの化合物 (a-2) は、単独であるいは2種 以上組み合わせて用いることができる。

【0022】本発明で用いられる他のラジカル重合性化 合物(a-3)の具体例としては、(メタ)アクリル酸 グリシジル、α-エチル (メタ) アクリル酸グリシジ ル、α-n-プロピル (メタ) アクリル酸グリシジル、 α-n-ブチル (メタ) アクリル酸グリシジル、3,4 ーエポキシブチル (メタ) アクリレート、3,4ーエポ キシヘプチル (メタ) アクリレート、αーエチルー6, **7ーエポキシヘプチル(メタ)アクリレート、アリルグ** リシジルエーテル、ビニルグリシジルエーテル、oービ ニルベンジルグリシジルエーテル、mービニルベンジル グリシジルエーテル、pービニルベンジルグリシジルエ ーテル、3 - ビニルシクロヘキセンオキサイドなどのエ ル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、se 50 ポキシ基含有ラジカル重合性化合物;(メタ)アクリル 酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリ ル酸-n-プロピル、(メタ)アクリル酸-i-プロピ ル、(メタ) アクリル酸-n-ブチル、(メタ) アクリ ル酸-sec-ブチル、(メタ) アクリル酸-ter-ブチル、(メタ) アクリル酸-2-エチルヘキシル、 (メタ) アクリル酸ラウリル、(メタ) アクリル酸ドデ シル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンタニル、(メ タ) アクリル酸イソボロニル、(メタ) アクリル酸シク ロヘキシル、(メタ) アクリル酸2-メチルシクロヘキ シル、(メタ)アクリル酸ジシクロヘキシル、(メタ) 10 単位を、好ましくは70重量%以下、特に好ましくは2 アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸アリル、 (メタ) アクリル酸プロバギル、(メタ) アクリル酸フ ェニル、(メタ)アクリル酸ナフチル、(メタ)アクリ ル酸アントラセニル、(メタ)アクリル酸シクロペンチ ル、(メタ)アクリル酸フリル、(メタ)アクリル酸テ トラヒドロフリル、(メタ)アクリル酸ピラニル、(メ タ) アクリル酸ペンジル、(メタ) アクリル酸フェネシ ル、(メタ)アクリル酸クレシル、(メタ)アクリル酸 -1,1,1-トリフルオロエチル、(メタ) アクリル酸 パーフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロ 20 -n-プロピル、(メタ) アクリル酸パーフルオロ-i ープロピル、(メタ)アクリル酸トリフェニルメチル、 (メタ)アクリル酸クミル、(メタ)アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ) アクリル酸-2-ヒドロキ シプロピル、(メタ) アクリル酸-アミド、(メタ) ア クリル酸-N,N-ジメチルアミド、(メタ)アクリル 酸-N,N-ジプロピルアミド、(メタ)アクリル酸-アニリド、(メタ) アクリロニトリルなどの (メタ) ア クリロイル基合有ラジカル重合性化合物:

【0023】アクロレイン、塩化ビニル、塩化ビニリデ 30 ン、Nービニルピロリドン、酢酸ビニル、スチレン、α ーメチルスチレン、oーメチルスチレン、mーメチルス チレン、pーメチルスチレン、pーメトキシスチレン、 pーメトキシメチルスチレン、p-tertーブトキシ スチレン、クロロメチルスチレン、ブタジエン、2,3 ージメチルブタジエン、イソプレンなどのビニル基含有 ラジカル重合性化合物;マレイン酸ジエチル、フマル酸 ジエチル、イタコン酸ジエチルなどの不飽和ジカルボン 酸ジエステルなどが挙げられる。

【0024】これらのうち、(メタ)アクリル酸グリシ 40 ジル、スチレン、αーメチルスチレン、pーtertブ トキシスチレン、メタクリル酸ジシクロペンタニル、メ タクリル酸メチル、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチ ル、メタクリル酸ベンジル、ブタジエン、イソプレンな どが好ましく用いられる。これらの化合物を共重合成分 として用いることにより、ポリマーのアルカリ溶解性、 ガラス転移温度、誘電率などをコントロールすることが でき、その結果、解像度、残膜率などのレジストとして の性能や、透明性、耐熱性などの永久膜としての性能が

独であるいは2種以上組み合わせて用いることができ る。

6

【0025】本発明で用いられる共重合体「A]は、上 記の各化合物を共重合させることにより得られる。共重 合体は不飽和カルボン酸(a-1)の重合単位を、好ま しくは5~50重量%、特に好ましくは10~40重量 %の量で、化合物 (a-2) の重合単位を、好ましくは 5~90重量%、特に好ましくは20~50重量%の量 で、そして他のラジカル重合性化合物 (a-3) の重合 0~60重量%の量で含有している。

【0026】不飽和カルボン酸(a-1)の重合単位の 含量が5重量%未満であると、得られる被膜はアルカリ 水溶液からなる現像液に対する溶解性が低下し現像性が 悪化して、感度が低下する場合がある。一方50重量% を超えると、得られる被膜はアルカリ水溶液に対する溶 解性が大きくなりすぎて、得られるレジストパターンの 残膜率が悪化する場合がある。また、化合物(a-2) の重合単位の含量が5重量%未満であると、得られる被 膜は架橋密度が不足して耐熱性や耐薬品性が劣ることが あり、一方90重量%を超えると、得られる被膜はアル カリ水溶液に対する溶解性が低下して現像性が悪化した り、感度が低下する場合がある。さらに、他のラジカル 重合性化合物(a-3)の重合単位の含量が70重量% を超える場合には、ポリマーのアルカリ水溶液からなる 現像液に対する溶解性のバランスが悪くなり、パターニ ングが困難になる場合がある。

【0027】 本発明で用いられる共重合体 [A] は、ボ リスチレン換算重量平均分子量(以下、「Mw」とい う) が、通常、2×10³~1×10⁵、好ましくは5× 103~5×104であることが望ましい。Mwが2×1 03未満であると、得られる被膜は、現像性、残膜率な どが低下したり、またパターン形状、耐熱性などに劣る ことがあり、一方1×105を超えると、感度が低下し たりパターン形状に劣ることがある。

【0028】上記のような本発明で用いられる共重合体 [A]は、不飽和カルボン酸(a-1)と、上記一般式 [I]で示される化合物 (a-2)と、場合によりさら に他のラジカル重合性化合物(a-3)を、種々の重合 方法により共重合させることによって得られるが、溶媒 中で、触媒(重合開始剤)の存在下に共重合させる方法 が好ましい。

【0029】共重合に用いられる溶媒の具体例として は、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノー ルなどのアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサ ンなどの環状エーテル類;メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテートなどのセロソルブエス テル類 ; エチレングリコールモノメチルエーテル、エチ レングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコ 向上する場合がある。これらの化合物(a-3)は、単 50 ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエ

チルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテ ル、ジエチレングリコールエチルメチルエーテル、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルなどのグリコール エーテル類; プロピレングリコールメチルエーテルアセ テート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート などのプロピレングリコールアルキルエーテルアセテー ト類;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化 水素類:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、2-ヘプタノン、4ーヒドロキシー4ーメチルー2ーペンタ 10 ノンなどのケトン類;2-ヒドロキシプロピオン酸エチ ル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、エト キシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2ーヒドロキ シー3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシプロピオ ン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エ トキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸 メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類;ジ メチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドンなど の非プロトン性極性溶媒が挙げられる。これらの溶媒 は、重合性化合物 [(a-1), (a-2) および (a-1)-3)]の合計100重量部に対して、通常20~10 00重量部の量で用いられる。

【0030】また、触媒としては、一般的にラジカル重 合開始剤として知られているものを広く用いることがで き、例えば2,2'-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、 2,2'-アゾビス(4-メトキシー2,4-ジメチルバ レロニトリル) などのアゾ化合物: ベンゾイルパーオキ ピパレート、1,1'ーピス(tーブチルパーオキシ) シクロヘキサンなどの有機過酸化物および過酸化水素な どを用いることができる。ラジカル重合開始剤として過 酸化物を用いる場合には、過酸化物を還元剤とともに用 いてレドックス型重合開始剤としてもよい。さらに、上 記共重合において、αーメチルスチレンダイマーなどの 分子量調節剤を添加することもできる。

【0031】上記共重合体 [A] は、不飽和カルボン酸 (a-1)に由来するカルボキシル基と上記一般式 [I]で示される化合物(a-2)に由来するアルコキ 40 シメチロール基とを有しており、アルカリ可溶性と自己 架橋性とを有する。また、共重合体 [A] は、アルカリ 水溶液に対して適度の溶解性を有しており、高感度、高 残膜率、現像性などに優れた感放射線性樹脂組成物を与 える。さらに共重合体 [A] を用いることによって得ら れるレジストパターンは、耐熱性、基板との密着性、可 視光域での透明性、耐薬品性などの諸特性に優れる。 【0032】[B] 1,2-キノンジアジド化合物 本発明で用いられる1,2-キノンジアジド化合物とし

ては、ヒドロキシ化合物の水酸基の全てまたは一部が

1,2-キノンジアジドスルホン酸でエステル化された 化合物を用いることができ、好ましくはヒドロキシ化合 物の水酸基の20~100%が1,2-キノンジアジド スルホン酸でエステル化された化合物を用いる。

8

【0033】このような1、2-キノンジアジド化合物 の具体例としては、2.3.4-トリヒドロキシベンゾフ ェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 酸エステル、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン -1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エス テル、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、 2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナ フトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどのト リヒドロキシベンゾフェノンの1,2-キノンジアジド スルホン酸エステル: 2,2',4,4'ーテトラヒドロ キシベンゾフェノンー1.2ーナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、2,2',4,4'-テトラヒ ドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジ ドー5ースルホン酸エステル、2,3,4,3'ーテトラ ヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジア ジドー4ースルホン酸エステル、2,3,4,3'ーテト ラヒドロキシベンゾフェノンー1,2-ナフトキノンジ アジドー5ースルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテ トラヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノン ジアジド-4-スルホン酸エステル、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン-1.2-ナフトキノ ンジアジドー5ースルホン酸エステル、2,3,4,2ーテトラヒドロキシー4'ーメチルベンゾフェノンー 1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステ シド、ラウロイルパーオキシド、セーブチルパーオキシ 30 ル、2,3,4,2'ーテトラヒドロキシー4'ーメチル ベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキ シー3'ーメトキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキ ノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2.3.4. 4'ーテトラヒドロキシー3'ーメトキシベンゾフェノ ンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸工 ステルなどのテトラヒドロキシベンゾフェノンの1,2 ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル :

> 【0034】2,3,4,2',6'ーペンタヒドロキシベ ンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ース ルホン酸エステル、2,3,4,2',6'ーペンタヒドロ キシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、3.4.5.2',4'-ペンタ ヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジア ジドー4-スルホン酸エステル、3,4,5,2′,4′ー ペンタヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノ ンジアジドー5ースルホン酸エステルなどのペンタヒド ロキシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジド スルホン酸エステル; 2,4,6,3',4',5'-ヘキ 50 サヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジ

アジドー4ースルホン酸エステル、2.4.6.3'、 4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、3, 4,5,3',4'5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノ ン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸工 ステル、3,4,5,3',4',5'-ヘキサヒドロキシ ベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルなどのヘキサヒドロキシベンゾフェ ノンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステ ル:

【0035】 ピス(2,4-ジヒドロキシフェニル)メ タン-1.2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸 エステル、ビス(2.4-ジヒドロキシフェニル)メタ ンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エ ステルなどのビスジヒドロキシフェニルメタンの1.2 ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル:ビス(p ーヒドロキシフェニル) メタンー1.2ーナフトキノン ジアジドー4ースルホン酸エステル、ビス (pーヒドロ キシフェニル) メタンー1,2-ナフトキノンジアジド -5-スルホン酸エステルなどのビスヒドロキシフェニ 20 ルメタンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸工 ステル; トリ (p-ヒドロキシフェニル) メタンー1, 2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、 トリ (p-ヒドロキシフェニル) メタン-1,2-ナフ トキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどのトリ ヒドロキシフェニルメタンの1.2-ナフトキノンジア ジドスルホン酸エステル:

【0036】1,1,1-トリ(pーヒドロキシフェニ ル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、1,1,1-トリ(p-ヒドロキシフェ 30 -ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、 ニル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステルなどのトリヒドロキシフェニルエタン の1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル; ピス(2,3,4ートリヒドロキシフェニル)メタンー 1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ル、ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル)メタン -1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エス テルなどのビストリヒドロキシフェニルメタンの1,2 ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル;2,2-ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル)プロパンー 40 1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ル、2,2-ピス(2,3,4-トリヒドロキシフェニ ル) プロパンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステルなどのビストリヒドロキシフェニルプ ロパンの1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エス テル; 1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4-ヒド ロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1,2-ナ フトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,1, 3ートリス(2,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニ ル)-3-フェニルプロパン-1,2-ナフトキノンジ

アジドー5ースルホン酸エステルなどのトリス(ジメチ ルヒドロキシフェニル)フェニルプロパンの1,2-ナ

10

フトキノンジアジドスルホン酸エステル: [0037]4,4'-[1-[4-[1-[4-t]]ロキシフェニル] -1 -メチルエチル] フェニル] エチ リデン] ビスフェノールー1.2ーナフトキノンジアジ ドー4ースルホン酸エステル、4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1-メチルエチ ル] フェニル] エチリデン] ビスフェノールー1.2-10 ナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどの ヒドロキシフェニルメチルエチルフェニルエチリデンビ スフェノールの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン 酸エステル; ビス(2,5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル) -2-ヒドロキシフェニルメタン-1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、 ビス (2.5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)-2-ヒドロキシフェニルメタン-1.2-ナフトキノンジア ジドー5ースルホン酸エステルなどのビス(ジメチルヒ ドロキシフェニル) ヒドロキシフェニルメタンの1.2 ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル;3,3, 3',3'ーテトラメチルー1.1'ースピロインデンー 5,6,7,5',6',7'-ヘキサノールー1,2-ナフ トキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、3,3, 3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロインデンー 5,6,7,5',6',7'-ヘキサノールー1,2-ナフ トキノンジアジドー5ースルホン酸エステルなどのテト ラメチルスピロインデンヘキサノールの1.2ーナフト キノンジアジドスルホン酸エステル:2,2,4ートリメ チルー7,2',4'ートリヒドロキシフラバンー1,2 2,2,4-トリメチル-7,2',4'-トリヒドロキシ フラバンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホ ン酸エステルなどのトリメチルトリヒドロキシフラバン の1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルが 挙げられる。

【0038】これらのうち、2,3,4ートリヒドロキシ ベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ー スルホン酸エステル、2.3.4-トリヒドロキシベンゾ フェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホ ン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベン ゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベ ンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステル、3,4,5,2',4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノンー1,2ーナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル) -3-フェニルプ ロパン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 酸エステル、1,1,3-トリス(2,5-ジメチルー4) 50 ーヒドロキシフェニル)ー3ーフェニルプロパンー1.

2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸エステル、 4.4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニ ル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビス フェノールー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル] -1-メチルエチル] フェニル] エチリデン] ビスフェノールー1,2-ナフトキノンジ アジドー5ースルホン酸エステル、2,2,4ートリメチ ルー7.2',4'ートリヒドロキシフラバンー1.2ー ナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2, 2,4-トリメチルー7,2',4'-トリヒドロキシフ ラバン-1.2- ナフトキノンジアジド-5-スルホ ン酸エステル、1,1,1-トリ (p-ヒドロキシフェニ ル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホン酸エステル、1,1,1-トリ (p-ヒドロキシフェ ニル) エタンー1,2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステルなどが好ましく用いられる。これらの 1,2-キノンジアジド化合物は、単独であるいは2種 以上組み合わせて用いることができる。

【0039】[C]潜在性酸発生剤

本発明で用いられる潜在性酸発生剤は、加熱により酸を 発生するカチオン重合触媒であり、スルホニウム塩、ベ ンゾチアゾリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩 などのオニウム塩が用いられる。中でも、スルホニウム 塩およびベンゾチアゾリウム塩が好ましい。

【0040】上記スルホニウム塩の具体例としては、4 ーアセトフェニルジメチルスルホニウムへキサフルオロ アンチモネート、4ーアセトキシフェニルジメチルスル ホニウムへキサフルオロアルセネート、ジメチルー4ー (ベンジルオキシカルボニルオキシ)フェニルスルホニ 30 ウムヘキサフルオロアンチモネート、ジメチルー4ー (ベンゾイルオキシ)フェニルスルホニウムへキサフル オロアンチモネート、ジメチルー4ー(ベンゾイルオキシ)フェニルスルホニウムへキサフルオロアルセネート、ジメチルー3ークロロー4ーアセトキシフェニルス ルホニウムへキサフルオロアンチモネートなどのアルキ ルスルホニウム塩;ベンジルー4ーヒドロキシフェニル メチルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、ベ ンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムへ 12

キサフルオロホスフェート、4ーアセトキシフェニルベンジルメチルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、ベンジルー4ーメトキシフェニルメチルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、ベンジルー2ーメチルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート、ベンジルー3ークロロー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムへキサフルオロアルセネート、4ーメトキシベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムへキサフルオロホスフェー10 トなどのモノベンジルスルホニウム塩;

【0041】ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジルー 4-ヒドロキシフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、4-アセトキシフェニルジベンジルスルホ ニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジルー4 ーメトキシフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、ジベンジルー3ークロロー4ーヒドロキシフ ェニルスルホニウムヘキサフルオロアルセネート、ジベ ンジルー3ーメチルー4ーヒドロキシー5ーtertー 20 ブチルフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネ ート、ベンジルー4ーメトキシベンジルー4ーヒドロキ シフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェートな どのジベンジルスルホニウム塩; p-クロロベンジルー 4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウムヘキサフル オロアンチモネート、p-ニトロベンジルー4-ヒドロ キシフェニルメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、p-クロロベンジルー4-ヒドロキシフェニ ルメチルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、p ーニトロベンジルー3ーメチルー4ーヒドロキシフェニ ルメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、 3,5-ジクロロベンジルー4-ヒドロキシフェニルメ チルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、o-クロロベンジルー3ークロロー4ーヒドロキシフェニル メチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネートなど の置換ベンジルスルホニウム塩;下記式(1)~(7) で示されるスルホニウム塩が挙げられる。

[0042]

【化3】

(2)
$$CH_3$$
CO CH_2 CH_2 CF_3SO_3

【0043】上記ベンゾチアゾニウム塩の具体例として 30*0、同SI-L145、同SI-L150、同SI-L ンチモネート、3-ベンジルベンゾチアゾリウムヘキサ フルオロホスフェート、3ーベンジルベンゾチアゾリウ ムテトラフルオロボレート、3-(p-メトキシベンジ ル) ベンゾチアゾリウムヘキサフルオロアンチモネー ト、3ーベンジルー2ーメチルチオベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルー5-ク ロロベンゾチアゾリウムヘキサフルオロアンチモネート などのベンジルベンゾチアゾリウム塩が挙げられる。

【0044】これらのうち、4ーアセトキシフェニルジ 40 メチルスルホニウムヘキサフルオロアルセネート、ベン ジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウムヘキ サフルオロアンチモネート、4-アセトキシフェニルベ ンジルメチルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー ト、ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-アセトキシフェニ ルベンジルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー ト、3-ベンジルベンゾチアゾリウムヘキサフルオロア ンチモネートなどが好ましく用いられる。これらの市販

160 (三新化学工業 (株) 製) などが挙げられる。こ れらの化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて 用いることができる。

【0045】他の成分

本発明の感放射線性樹脂組成物は、感度をさらに向上さ せる目的で、1,2-キノンジアジド化合物に対する増 **感剤を含んでいてもよい。このような増感剤としては、** 2H-UVF-(3,2-b)-1,4-x+y-2-3(4H) - オン、10H-ビリドー (3,2-b) - 1,4-ペンゾチアジン、ウラゾール類、ヒダントイン類、 バルビツール酸類、グリシン無水物類、1-ヒドロキシ ベンゾトリアゾール類、アロキサン類、マレイミド類な どが挙げられる。上記増感剤は、1,2-キノンジアジ ド化合物100重量部に対して、通常100重量部以 下、好ましくは10重量部以下の量で必要に応じて用い られる。

【0046】また、本発明の感放射線性樹脂組成物は、 耐熱性、基板との密着性をさらに向上させる目的で、分 子内に少なくとも2個のエポキシ基を有するラジカル重 品としては、サンエイドSI-L85、同SI-L11*50 合性を有さない化合物を含んでいてもよい。このような

化合物としては、例えばエピコート1001、同100 2、同1003、同1004、同1007、同100 9、同1010、同828 (商品名;油化シェルエポキ シ (株) 製) などのビスフェノールA型エポキシ樹脂; エピコート807(商品名:油化シェルエポキシ(株) 製) などのビスフェノールF型エポキシ樹脂; エピコー ト152、同154 (商品名;油化シェルエポキシ (株) 製)、EPPN201、同202(商品名;日本 化薬 (株) 製) などのフェノールノボラック型エポキシ 樹脂; EOCN102、同103S、同104S、10 10 20、1025、1027(商品名;日本化薬(株) 製)、エピコート180S75 (商品名;油化シェルエ ボキシ (株) 製) などのクレゾールノボラック型エボキ シ樹脂:エピコート1032H60、同XY-4000 (商品名:油化シェルエボキシ(株)製)などのポリフ ェノール型エポキシ樹脂; CY-175、同177、同 179、アラルダイトCY-182、同192、184 (商品名; チバガイギー(株)製)、ERL-423 4、4299、4221、4206 (商品名; U.C.C 社製)、ショーダイン509(商品名;昭和電工(株) 製)、エピクロン200、同400(商品名;大日本イ ンキ(株)製)、エピコート871、同872(商品 名;油化シェルエポキシ(株)製)、ED-5661、 同5662(商品名;セラニーズコーティング(株) 製)などの環状脂肪族エポキシ樹脂;エポライト100 MF(共栄社油脂化学工業(株)製)、エピオールTM P (日本油脂 (株) 製) などの脂肪族ポリグリシジルエ

【0047】 これらの化合物は、共重合体 [A] 100 いられる。

ーテルが挙げられる。

【0048】さらに本発明の感放射線性樹脂組成物は、 ストリエーション (塗布すじあと) の防止、現像性の向 上などの目的で、界面活性剤を配合することもできる。 界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリ ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、 ポリオキシエチレンオレイルエーテルなどのポリオキシ エチレンアルキルエーテル類;ポリオキシエチレンオク チルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェ ニルエーテルなどのポリオキシエチレンアリールエーテ 40 ル類; ポリオキシエチレンジラウレート、ポリオキシエ チレンジステアレートなどのポリオキシエチレンジアル キルエステル類などのノニオン系界面活性剤 ; エフトッ プEF301、同303、同352(新秋田化成(株) 製)、メガファックF171、同F172、同F173 (大日本インキ化学工業(株)製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム (株) 製)、 アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同S C-101、同SC-102、同SC-103、同SC -104、同SC-105、同SC-106 (旭硝子

16

(株) 製) などのフッ素系界面活性剤; オルガノシロキ サンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製)、ポ リフローNo. 57、同95 (共栄社油脂化学工業 (株)製)などの(メタ)アクリル酸共重合体系界面活 性剤が挙げられる。上記界面活性剤は、感放射線性樹脂 組成物の固形分に対して、2重量%以下、好ましくは1 重量%以下の量で必要に応じて用いられる。

【0049】その他、本発明の感放射線性樹脂組成物 は、基板との密着性をさらに向上させる目的で、密着助 剤を含んでいてもよい。このような密着助剤としては、 官能性シランカップリング剤などが挙げられる。さらに 本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、必要に応じて帯 電防止剤、保存安定剤、消泡剤、顔料、染料などを含ん でいてもよい。

【0050】感放射線性樹脂組成物

本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の共重合体 [A]、1.2-キノンジアジド化合物、潜在性酸発生 剤および必要に応じて他の成分からなるが、共重合体 [A] 100重量部に対して、1,2-キノンジアジド 20 化合物 [B]を好ましくは5~100重量部、特に好ま しくは10~50重量部、潜在性酸発生剤 [C]を、好 ましくは0.1~50重量部、特に好ましくは1~10 重量部含んでいることが望ましい。

【0051】感放射線性樹脂組成物中の1,2ーキノン ジアジド化合物の量が、共重合体 [A] 100重量部に 対して5重量部未満であると、該組成物から形成される 塗膜は放射線照射部と放射線未照射部との溶解度差が小 さくなって現像によるパターニングが困難になることが あり、一方100重量部を超えると、短時間の放射線照 重量部に対して、50重量部以下の量で必要に応じて用 30 射では1,2-キノンジアジド化合物が充分に分解され ず、恩度が低下してしまうことがある.また、潜在性酸 発生剤の量が、共重合体 [A] 100重量部に対して 0.1重量部未満であると、加熱時に発生する酸の量が 少ないため、系の架橋密度が十分に上がらず、耐薬品性 が低下する場合がある。一方50重量部を超えると、保 存中に潜在性酸発生剤が樹脂組成物溶液中に折出してく る場合がある。

> 【0052】本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の 各成分を均一に混合することによって容易に調製するこ とができ、通常、適当な溶媒に溶解されて溶液状態で用 いられる。例えば、共重合体 [A]を溶媒に溶解し、こ の溶液に1,2ーキノンジアジド化合物、潜在性酸発生 剤および必要に応じて他の成分を所定の割合で混合する ことにより、溶液状態の感放射線性樹脂組成物を調製す ることができる。

【0053】該溶媒としては、共重合体 [A]を製造す る際に用いられた溶媒と同様の溶媒を用いることができ る。さらに、Nーメチルホルムアミド、N,Nージメチ ルホルムアミド、N-メチルホルムアニリド、N-メチ 50 ルアセトアミド、N, N – ジメチルアセトアミド、N –

-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエ チルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニルアセト ン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタ ノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベ ンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン 酸ジエチル、アーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸 プロピレン、フェニルセロソルブアセテートなどの溶媒 を用いることもできる。

【0054】これらの溶媒のうち、溶解性および塗膜の 形成のし易さから、エチレングリコールモノエチルエー 10 テル、プロピレングリコールモノメチルエーテルなどの グリコールエーテル類;エチルセロソルブアセテート、 プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールエチルエーテルアセテートなどのエチ レングリコールアルキルエーテルアセテート類:乳酸エ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチルなどのエステ ル類: ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエ チレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコ ールエチルメチルエーテルなどのジエチレングリコール 類:2-ヘプタノンなどのケトン類が好ましく用いられ 20 **5.**

【0055】本発明の感放射線性樹脂組成物は、固形分 | 濃度が好ましくは20~40重量%となるように溶媒に 溶解された溶液として被塗布物に塗布される。また、上 記のように調製された感放射線性樹脂組成物溶液は、孔 径が0.2μm程度のフィルタなどを用いて沪過した 後、使用に供することが好ましい。このように調製され た感放射線性樹脂組成物溶液は、長期間の貯蔵安定性に も優れる。

【0056】使用法

上記感放射線性樹脂組成物溶液は、基板表面に塗布し、 加熱により溶媒を除去することによって、塗膜を形成す ることができる。基板表面への感放射性樹脂組成物溶液 の塗布方法は、例えばスプレー法、ロールコート法、回 転塗布法などの各種の方法を採用することができる。

【0057】次いで、形成された塗膜は、加熱(プレベ ーク) される。加熱条件は、各成分の種類、配合割合な どによっても異なるが、通常60~120℃で10~6 00秒間程度である。

【0058】次に加熱された塗膜に所定パターンのマス 40 クを介して放射線を照射した後、現像液により現像し、 不要な部分を除去する。現像液としては、例えば水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸 ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア、エチ ルアミン、nープロピルアミン、ジエチルアミン、ジー nープロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチ ルアミン、N-メチルピロリドン、ジメチルエタノール アミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキ シド、コリン、ピロール、ピペリジン、1.8-ジアザ 50

ビシクロ[5.4.0] -7-ウンデセン、1,5-ジア ザビシクロ [4.3.0] -5-ノナンなどのアルカリ類 からなるアルカリ水溶液を用いることができる。該アル カリ水溶性の濃度は、通常0.1~2.5重量%、好まし くは0.2~0.5重量%である。また上記アルカリ水溶 液に、メタノール、エタノールなどの水溶性有機溶媒、 界面活性剤などを適当量添加した水溶液を現像液として 使用することもできる。

【0059】現像時間は、通常30~180秒間であ り、また現像方法は液盛り法、ディッピング法などのい ずれでもよい。現像後、流水洗浄を30~90秒間行 い、圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、基 板上の水分を除去し、パターン状被膜が形成される。そ の後このパターン状被膜に、高圧水銀灯などによる放射 線を全面照射し、パターン状被膜中に残存する1.2-キノンジアジド化合物を完全に分解させる。続いて、ホ ットプレート、オーブンなどの加熱装置により、所定温 度、例えば150~250℃で、所定時間、例えばホッ トプレート上なら5~30分間、オーブン中では30~ 90分間加熱処理をすることによって、パターン状架橋 被膜を得る。

[0060]

【実施例】次に本発明を実施例により具体的に説明する が、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。 【0061】共重合体 [A] の合成

合成例1 (共重合体 [A-1]の合成)

撹拌機、冷却管、窒素導入管および温度計を装着したセ パラブルフラスコに、表1に示す各化合物を仕込み、3 0分間窒素でパージした後、セパラブルフラスコを油浴

30 に浸し、内温を80℃に保って4時間重合反応を行っ た。得られた重合体溶液の固形分濃度は、40.5重量 %であり、重合反応が100%進行したことが確認され た。また、共重合体 [A-1] のMwは、1.12×1 Ofであった。なお、Mwは、GPC(ゲルパーミエイ ションクロマトグラフィ) (東ソー(株)製HLC-8 020)を用いて測定したポリスチレン換算分子量であ る(以下、同じ)。これらの結果を表1に示す。

【0062】合成例2~5(共重合体 [A-2]~ [A -6]の合成)

合成例1において、表1に示すような各成分および溶媒 を表1に示す量で仕込んだ以外は、合成例1と同様にし て共重合体 [A-2] ~ [A-6] を含む重合体溶液を 得た。得られた各重合体溶液の固形分濃度およびMwを 表1に示す。

[0063]

【表1】

| | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 |
|--|------|------|----------|------|---------|------|
| (a-1) メタクリル酸 (g) アクリル酸 (g) | 20 | 3.0 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| (a-2) pービニルベンジルメチルエーテル (g) | 09 | 9 2 | 35 | 35 | 20 | |
| (a-3) メタクリル酸ジンクロベンタニル (g) インナレン (e) | 20 | 77 | 3.7 5 | 87 | 86 5 | 80 |
| スチレン (g) メタクリル酸グリンジル (g) | | | • | • | 20 | 10 |
| 第合限的的 ジメチル2, 2'ーアゾピス (2ーメチルプロピオネート) (8) | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | в |
| 分子量組織剤 αーメチルスチレンダイマー (g) | | 8 | | | | |
| 裕様 ジェチレングリコールメチルエチルエーテル (g) 乳酸エチル (D) | 160 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 電合体的後の回形分離疾(電量96) | 40.5 | 34.5 | 49.8 | 50.1 | 51.0 | 32.3 |
| 近星平均分子量 (×10⁴) | 1.12 | 2.33 | 0.98 | 1.28 | 1.11 | 1.45 |

【0064】感放射線性樹脂組成物の調製 実施例1

合成例1で得られた共重合体 [A-1] 100重量部 (固形分)、1,2-キノンジアジド化合物として4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェ 40ノール(1モル)と1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド(2モル)との縮合物([B-1])30重量部および潜在性酸発生剤としてサンエイドSI-L150(三新化学工業(株)製)1.0重量部とを混合し、固形分濃度が35重量%になるようにジエチレングリコールエチルメチルエーテルに溶解させた後、孔径0.45μmのミリボアフィルタで沪遏して感放射線性樹脂組成物溶液を調製した。

【0065】実施例2~19、比較例1~2 [現像性]現像後のパターン状被膜の表面荒れ、スペー 実施例1において、表3に示すような各成分に代えた以 50 ス部分の現像残り(スカム)の有無を走査型電子顕微鏡

外は、実施例1と同様にして感放射線性樹脂組成物溶液 を調製した。

20

【0066】なお、表3中、成分の略称は次の化合物を示す。

[B-1]・・・4,4'-[1-[4-[1-[4-ヒドロキシフェニル]-1-メチルエチル]フェニル] エチリデン] ピスフェノール (1モル) と1,2ーナフトキノンジアジドー5-スルホン酸クロリド (2モル) との総合物

10 [B-2]・・・1,1,3-トリス(2,5-ジメチル -4-ヒドロキシフェニルー3-フェニル) プロパン (1モル)と1,2-ナフトキノンジアジドー5-スル ホン酸クロリド(1.9モル)との縮合物 [B-3]・・・2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェ ノン(1モル)と1,2-ナフトキノンジアジドー5-スルホン酸クロリド(2.6モル)との縮合物 [B-4]・・・2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベ ンゾフェノン(1モル)と1,2-ナフトキノンジアジ ドー4-スルホン酸クロリド(4モル)との縮合物[C 20 -1]・・・スルホニウム塩;サンエイドSI-L15

0 (三新化学工業(株)製)[C-2]・・・トリフルオロメタンスルホン酸メチル (p-ヒドロキシフェニル) (p-メチルベンジル)スルホニウム

【0067】感放射線性樹脂組成物の評価 実施例および比較例で得られた感放射線性樹脂組成物に ついて、下記のようにパターン状被膜を形成して評価し た。結果を表3に示す。

(i)4インチのシリコンウェハに、各実施例で得られ 50 た感放射線性樹脂組成物溶液をスピンナーを用いて塗布 した後、90℃で4分間ホットプレート上で加熱して膜 厚4.0μmの塗膜を形成した。

(ii)得られた塗膜を、(株)ニコン製NSR-1755i7A縮小投影露光機 (NA=0.50、λ=365nm)により露光時間を変化させて露光した後、0.5重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて、25℃で1分間現像し、水でリンスし、乾燥することによりシリコンウェハ上にパターン状被膜を形成した。

10 【0068】評価項目と評価方法を以下に示す。

[感度] 上記のようにして作成されたパターン状被膜において、ライン線幅2.0 μ mのパターン状被膜が得られるのに必要な露光時間(以下、「最適露光時間」という。) を求めた。

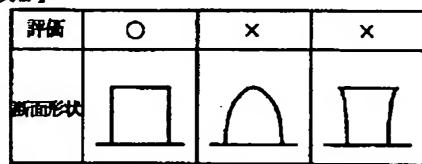
[解像度] 最適露光時間において解像している最小のスペースパターンの寸法を走査型電子顕微鏡で測定した。 [残膜率] (現像後の膜厚/現像前の膜厚)×100を求め、90%以上をOとし、90%未満を×とした。 [現像性] 現像後のパターン状被膜の表面荒れ、スペース部分の現像残り(スカム)の有無を走査型電子顕微鏡

で観察した。スカムが認められなかったときを〇とし、 認められたときを×とした。

【0069】 [パターン形状] 最適露光時間におけるパターン状被膜の断面形状を走査型電子顕微鏡で観察した。断面形状の評価基準を表2に示す。形状がAのように正方形あるいは長方形の場合は良好(〇)とし、BあるいはCのようにAの形状とは異なることが認められたときは不良(×)とした。

[0070]

【表2】



【0071】 [最適硬化温度と耐熱性] 約100μm× 100μmのパターン状被膜が形成されたシリコンウェハに、365nmにおける光強度が5mwの紫外線を60秒間照射した後、各温度でホットプレートにより1520分間加熱した。架橋パターン状被膜が形成されたシリコンウェハをジメチルスルホキシドに80℃で15分間浸費した。表面に荒れが認められず、且つ浸責前後の膜厚の変化率が5%未満となる温度を最適硬化温度とした。最適硬化温度で加熱したパターン状被膜をさらに1時間加熱し、熱分解による膜減りが3%以上となる温度を調べた。この温度が最適硬化温度よりも30℃以上ある場*

* 合を○とし、10℃以上30℃未満を△、10℃未満を ×とした。

22

【0072】「光線透過率)約100μm×100μmのパターン状被膜をコーニング社製7059ガラス基板上に作製し、最適硬化温度で加熱した。このパターンの400m~780nmの光線透過率を測定し、最低透過率が90%以上のものを〇、80%以上90%未満を △、80%未満を×とした。

【0073】 [密着性] 0.66μmの熱酸化膜付きシ10 リコンウェハを用いて、5.0μmL/Sパターン状被膜を形成し、最適硬化温度で5分間ホットプレートで加熱した。加熱されたシリコンウェハを、40重量%フッ化アンモニウム水溶液と50重量%フッ化水素水溶液との6:1(容量比)混合液である25℃エッチング液に6分間浸漬し、パターン状被膜のアンダーカット(表2で示されるパターン形状の最上部と最下部のパターン幅の差)を走査型電子顕微鏡で観察し、1.0μm未満を○とし、1.0μm以上1.3μm未満を△とし、1.3μm以上を×とした。

○【0074】[保存安定性] 感放射線性樹脂組成物溶液を5℃で3か月間保存した後、上記方法でパターン状被膜を形成し、上記と同様な評価を行って、調製直後の感放射線性樹脂組成物との結果を比較した。この調製直後の感放射線性樹脂組成物を同等の評価結果が得られた場合を、良好として判断した。

[0075]

【表3】

| | 機能 | 1,2-\$ <i> </i> 7%** T% * | 潜在性 配产生用 | 感度 | 解像度 | 残膜率 | 現像性 | パタ-ツ 形状 | 最適便 化温度 | 耐熱性 | | 密着性 | 解安定 |
|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|------|-----|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | (水成分) | (Bit23)/PHR) | (O5553)/1PHR | (mj/cm²) | (µm) | · | | | (C) | | *** | | 性 |
| 実例1 | A-1 | B-1(30) | C-1 | 250 | 8.0 | O | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 敀 |
| " 2 | A-2 | B-1(30) | C-1 | 200 | 8.0 | Q | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 與 |
| " 3 | A-3 | B-1(30) | C-1 | 250 | 0.8 | O | 0 | Q | 180 | 0 | 0 | 0 | 婌 |
| <i>P</i> 4 | A-4 | B-1(30) | C-1 | 250 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 良好 |
| 7 5 | A-5 | B-1(30) | C-1 | 200 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 殷好 |
| " 6 | A-1 | B-2(25) | C-1 | 300 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 與 |
| 7 | A-2 | B-2(25) | C-1 | 250 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 180 | o | Q | Q | 破 |
| <i>"</i> 8 | A-3 | B-2(25) | C-1 | 300 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 與 |
| 79 | A-4 | B-2(25) | C-1 | 300 | 0.7 | | 0 | 0 | 190 | 0 | Q | Q | 腴 |
| #10 | A-5 | B-2(25) | C-1 | 250 | 0.7 | LO | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | Q | 與 |
| "11 | A-1 | B-2(25) | C-2 | 300 | 0.7 | O | 0 | 0 | 160 | 0 | | | 朗 |
| #12 | A-2 | B-2(25) | C-2 | 250 | 0.7 | Q | Q | 0 | 170 | 0 | 0 | Q | 與狂 |
| #13 | A-3 | B-2(25) | C-2 | 300 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 段好 |
| "14 | A-4 | B-2(25) | C-2 | 300 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 180 | O | 0 | Q | 朗 |
| "15 | A-5 | B-2(25) | C-2 | 250 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | O | 0 | 朗 |
| #16 | A-3 | B-3(30) | C-1 | 200 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | Q | 翅 |
| "17 | A-3 | B-3(30) | C-2 | 200 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 破 |
| 718 | A-3 | B-4(27) | C-1 | 250 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 破 |
| #19 | A-3 | B-4(27) | C-2 | 250 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 鮾 |
| 比较例1 | A-1 | B-1(30) | なし | 250 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 240 | × | × | Δ | 破 |
| " 2 | A-6 | B-1(30) | C-1 | 250 | 0.8 | × | 0 | Δ | 220 | Δ | 0 | 0 | 與 |

[0076]

※性に優れるとともに、とりわけ耐薬品性に優れた被膜

【発明の効果】本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、

(パターン)を形成することができる。このような本発

感度、現像性、残膜率、耐熱性、基板との密着性、透明※50 明の感放射線性樹脂組成物は、半導体集積回路(IC)

および液晶ディスプレイ (LCD) 用薄膜トランジスタ (TFT) 回路のみならず、回路製造用のマスクなどを 作成するためなどのボジ型レジストとして、さらには層 間絶縁膜、カラーフィルタ用保護膜などの永久膜用形成 材料としても好適である。

【0077】以上、詳述した本発明の感放射線性樹脂組 成物について、好ましい態様を下記する。

- 1. 上記共重合体が、(a-3)上記不飽和カルボン酸 と上記アルコキシ基含有ラジカル重合性化合物と共重合 有する請求項1記載の感放射線性樹脂組成物。
- 2. 共重合体 [A] が (a-1) 成分を5~50重量 %、(a-2)成分を5~90重量%、そして、(a-3)成分を5~70重量%共重合してなる組成物。
- 3. 共重合体 [A]の(a-1)成分がメタクリル酸 またはアクリル酸から選択される少なくとも1種であ り、(a-2)成分がo-ビニルベニジルメチルエーテ

24

- ル、mービニルベンジルメチルエーテルおよびpービニ ルベンジルメチルエーテルから選択される少なくとも1 種であり、そして (a-3) 成分がメタクリル酸グリシ ジル、メタクリル酸ジシクロペンタニル、スチレン、イ ソプレンの少なくともいずれかである組成物。
- 4. 共重合体 (A) のポリスチレン換算重量平均分子量 が2×10³~1×10⁵である組成物。
- 5. 潜在性酸発生剤が、加熱により酸を発生するオニウ ム塩である組成物。
- しうる他のラジカル重合性化合物の重合単位をさらに含 10 6. オニウム塩が、スルホニウム塩およびベンゾチアゾ リウム塩の少なくともいずれかである上記5の組成物。 7. 共重合体 [A] 100重量部に対して、1,2-キ ノンジアジド化合物を5~100重量部、より好ましく は10~50重量部、潜在性酸発生剤を0.1~50重 量部、より好ましくは1~10重量部含有している組成 物。

フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 昌之

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内